

半导体Ptfе清洗篮 12英寸晶圆湿法蚀刻架 耐酸碱含氟聚合物承载架

货号: PL-CP81



简介

这款12英寸聚四氟乙烯晶圆清洗篮专为高纯度半导体环境设计，在关键湿法蚀刻和清洗工艺中具备出色的耐化学腐蚀性，定制结构可为晶圆提供可靠支撑，并保证加工液体充分接触，满足精密制造要求。

了解更多

应用场景	说明	核心优势
RCA清洗	用于去除有机污染物和金属杂质的标准清洗流程（SC-1和SC-2步骤）	可防止高低pH值切换过程中发生二次污染
HF蚀刻	使用氢氟酸溶液去除牺牲氧化层或自然氧化层	完全耐受氢氟酸腐蚀，保证设备长期使用寿命
食人鱼蚀刻	使用硫酸和过氧化氢高温混合溶液去除光刻胶	可承受极端放热反应，不会发生结构软化
CMP后漂洗	化学机械抛光后去除浆料颗粒和化学品	接触点极少，可避免颗粒卡在晶圆背面
太阳能电池制绒	对大尺寸硅晶圆进行酸或碱制绒处理，提高光吸收率	在持续接触化学品的环境中仍可长期批量使用，耐久性出色
MEMS制造	对硅或玻璃基底进行深度湿法蚀刻，制造微机械结构	优化的流体循环设计，确保蚀刻速率均匀
光刻工艺	使用专用有机溶剂显影和去除光刻胶	耐溶剂材料可防止有机物渗出到显影液中
兆声清洗	通过高频声波清洗去除晶圆表面亚微米颗粒	材料密度可有效传输声能，不会产生阻尼衰减效应

特性	规格详情（PL-CP81）
主要材料	高纯度全新PTFE（聚四氟乙烯）
兼容晶圆直径	300mm（12英寸）- 可根据需求定制其他尺寸
结构配置	单晶圆承载架 / 多晶圆花篮式结构
制造工艺	精密CNC加工 / 定制生产
耐化学性	全pH范围兼容（0-14）；耐受HF、HNO ₃ 、HCl、H ₂ SO ₄ 、KOH等各类化学品
工作温度	可在最高260°C下持续使用（可根据设计定制温度范围）
槽位间距	可根据流体流量或容量需求完全定制
接触类型	支持点接触或边缘接触设计
手柄选项	固定式、可拆卸式或自动机械臂法兰接口
表面处理	超光滑加工表面，最大程度减少颗粒附着
纯度标准	符合半导体等级要求；可提供痕量金属检测报告